

PNP SILICON DUAL TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500 /336

DEVICES

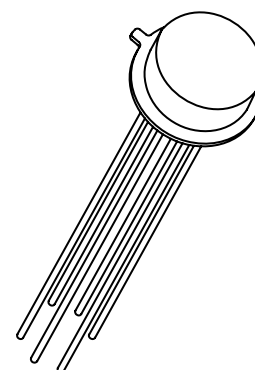
2N3810 2N3811
2N3810L 2N3811L
2N3810U 2N3811U

LEVELS

JAN
JANTX
JANTV
JANS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value		Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60		Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60		Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0		Vdc
Collector Current	I_C	50		mA _{dc}
		One Section ¹	Both Sections ²	
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}$	P_T	200	350	mW
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-65 to +200		$^\circ\text{C}$



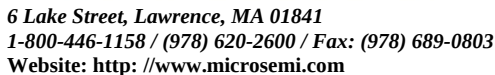
TO-78

Note:

- Derate linearly 1.143mW/ $^\circ\text{C}$ for $T_A > +25^\circ\text{C}$ (one section)
- Derate linearly 2.00mW/ $^\circ\text{C}$ for $T_A > +25^\circ\text{C}$ (both sections)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 100\mu\text{A}_{dc}$	$V_{(BR)CEO}$	60		Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 50\text{Vdc}$ $V_{CB} = 60\text{Vdc}$	I_{CBO}		10 10	ηA_{dc} μA_{dc}
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 4.0\text{Vdc}$ $V_{EB} = 5.0\text{Vdc}$	I_{EBO}		10 10	ηA_{dc} μA_{dc}



PNP SILICON DUAL TRANSISTOR
Qualified per MIL-PRF-19500 /336

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS				
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 10\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ 2N3810, 2N3810L, 2N3810U $I_C = 100\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 1.0\text{mAdc}$, $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 10\text{mAdc}$, $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$	h_{FE}	100 150 150 125	450 450	
$I_C = 1.0\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ 2N3811, 2N3811L, 2N3811U $I_C = 10\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 100\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 1.0\text{mAdc}$, $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 10\text{mAdc}$, $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$	h_{FE}	75 225 300 300 250	900 900	
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 100\mu\text{Adc}$, $I_B = 10\mu\text{Adc}$ $I_C = 1.0\text{mAdc}$, $I_B = 100\mu\text{Adc}$	$V_{CE(sat)}$		0.2 0.25	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 100\mu\text{Adc}$, $I_B = 10\mu\text{Adc}$ $I_C = 1.0\text{mAdc}$, $I_B = 100\mu\text{Adc}$	$V_{BE(sat)}$		0.7 0.8	Vdc
Base-Emitter Non-Saturation Voltage $V_{CE} = 5.0\text{Adc}$, $I_C = 100\mu\text{Adc}$	V_{BE}		0.7	Vdc

Forward Current Transfer Ratio, Magnitude I _C = 500μAdc, V _{CE} = 5.0Vdc, f = 30MHz I _C = 1.0mAdc, V _{CE} = 5.0Vdc, f = 100MHz	h _{fe}	1.0 1.0	5.0	
Small-Signal Short Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 1.0mAdc, V _{CE} = 10Vdc, f = 1.0kHz 2N3810, 2N3810L , 2N3810U 2N3811, 2N3811L , 2N3811U	h _{fe}	150 300	600 900	
Small-Signal Short Circuit Input Impedance I _C = 1.0mAdc, V _{CE} = 10Vdc, f = 1.0kHz 2N3810, 2N3810L , 2N3810U 2N3811, 2N3811L , 2N3811U	h _{je}	3.0 3.0	30 40	kΩ
Small-Signal Short Circuit Output Admittance I _C = 1.0mAdc, V _{CE} = 10Vdc, f = 1.0kHz 2N3810, 2N3810L , 2N3810U 2N3811, 2N3811L , 2N3811U	h _{oe}	5.0	60	μmhos
Output Capacitance V _{CB} = 5.0Vdc, I _E = 0, 100kHz ≤ f ≤ 1.0MHz	C _{obo}		5.0	pF
Input Capacitance V _{EB} = 5.0Vdc, I _C = 0, 100kHz ≤ f ≤ 1.0MHz	C _{Ibo}		8.0	pF



6 Lake Street, Lawrence, MA 01841
1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803
Website: <http://www.microsemi.com>

TECHNICAL DATA SHEET

PNP SILICON DUAL TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500 /336

DYNAMIC CHARACTERISTICS (cont.)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Noise Figure				
$I_C = 100\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 10\text{Vdc}$, $f = 100\text{Hz}$, $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3810, L, U	F_1		7.0	dB
$I_C = 100\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 10\text{Vdc}$, $f = 1.0\text{kHz}$, $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3810, L, U	F_2		3.0	
$I_C = 100\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 10\text{Vdc}$, $f = 10\text{kHz}$, $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3810, L, U	F_3		2.5	
$I_C = 100\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 10\text{Vdc}$, $f = 10\text{Hz to } 15.7\text{kHz}$, $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3810, L, U	F_4		3.5	
$I_C = 100\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 10\text{Vdc}$, $f = 100\text{Hz}$, $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3811, L, U	F_1		4.0	dB
$I_C = 100\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 10\text{Vdc}$, $f = 1.0\text{kHz}$, $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3811, L, U	F_2		1.5	
$I_C = 100\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 10\text{Vdc}$, $f = 10\text{kHz}$, $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3811, L, U	F_3		2.0	
$I_C = 100\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 10\text{Vdc}$, $f = 10\text{Hz to } 15.7\text{kHz}$, $R_G = 3.0\text{k}\Omega$ 2N3811, L, U	F_4		2.5	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9